

权利要求书

1.一种半导体结构，包括：

位于厚度大于 1.2 μm 的光刻胶层中沿第一方向排列的若干个第一图案和沿第二方向排列的若干个第二图案，所述第一方向与所述第二方向具有夹角；

所述第一图案在所述第一方向上具有第一排列长度，所述第二图案在所述
5 述第二方向上具有第二排列长度，各所述第一图案和各所述第二图案的面积之和小于所述第一排列长度与所述第二排列长度乘积的 1/2。

2.根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中所述第一图案和所述第二图案均为空隙图案。

3.根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中所述第一图案为空隙图案，
10 所述空隙图案的宽度为 0.5 μm -1.5 μm ，或/和相邻的两个所述空隙图案的间距为 0.5 μm -1.5 μm 。

4.根据权利要求 3 所述的半导体结构，其中所述第二图案为光刻胶图案，所述光刻胶图案的宽度为 1.5 μm -3.5 μm ，相邻的两个所述光刻胶图案的间距为 0.5 μm -1.5 μm 。

5.根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中所述第一图案和所述第二图
15 案均为光刻胶图案，所述光刻胶图案的宽度为 2 μm -3 μm ，相邻的两个所述第一图案的间距为 1 μm -1.5 μm ，相邻的两个所述第二图案的间距为 1 μm -1.5 μm 。

6.根据权利要求 1 所述的半导体结构，其特征在于，所述第一图案沿第一方向等间距排列，所述第二图案沿所述第二方向等间距排列。

7.根据权利要求 1 所述的半导体结构，其中所述第一方向与所述第二方向
20 向夹角为 90°。

8.根据权利要求 4 所述的半导体结构，其中所述光刻胶层中还形成有若

干个第一图形和若干个第二图形，所述第一图形的排布方向与所述第一方向平行，所述第二图形的排布方向与所述第二方向平行。

9.根据权利要求 8 所述的半导体结构，其中所述第一图形为间隙图形，所述第二图形为光刻胶图形。

5 10.根据权利要求 9 所述的半导体结构，其中所述第一图形的宽度为 0.5um-1.5um；所述第二图形的宽度为 1.5um-3.5um。

11.根据权利要求 4 所述的半导体结构，其中所述第一图案和所述第二图案之间的距离大于所述第一图案之间的间距和所述第二图案之间的间距之和。